

DE5SC6M

60V 5A

特長

- SMD
- PRRSM アバランシエ保証
- 小型大電流容量

Feature

- SMD
- PRRSM Rating
- High Io Rating・Small-PKG

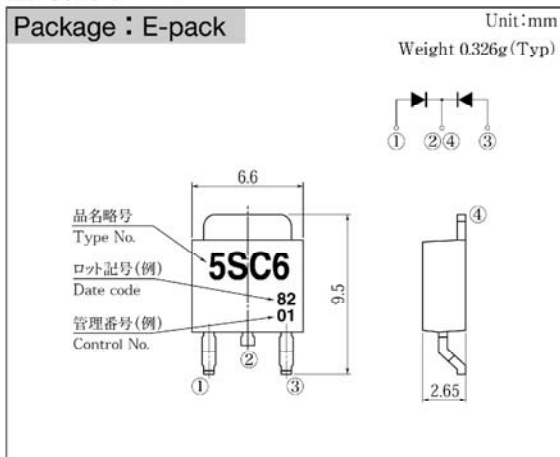
用途

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- 家電、ゲーム、OA 機器
- 通信、ポータブル機器

Main Use

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

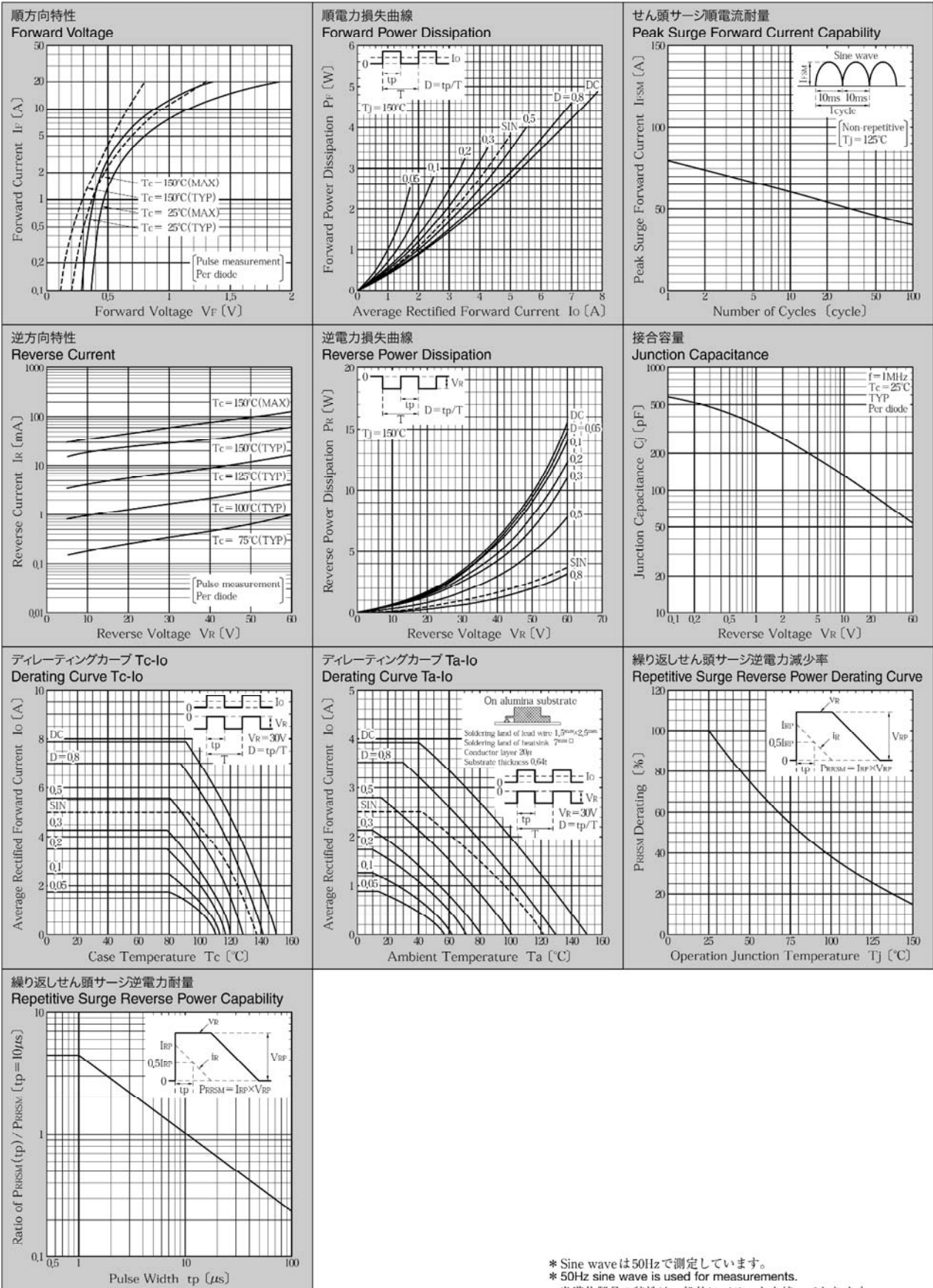
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DE5SC6M	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-40~150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			60	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V_{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		65	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load 1素子当りの出力電流平均値 $I_o/2$ Per diode $I_o/2$	$T_a = 42^\circ\text{C}$ アルミナ基板実装 On alumina substrate	2.5	A
			$T_c = 92^\circ\text{C}$	5	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 125^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 125^\circ\text{C}$		80	A
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	P_{RRSM}	パルス幅10 μs , 1素子当り, $T_j = 25^\circ\text{C}$ Pulse width 10 μs , Per diode, $T_j = 25^\circ\text{C}$		330	W

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 2.5\text{A}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.58	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 2.5	mA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f = 1\text{MHz}$, $V_R = 10\text{V}$, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 130	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 12	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	θ_{ja}	接合部・周囲間, アルミナ基板実装 Junction to ambient, On alumina substrate	MAX 55	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical is a statistical average of the device's ability.
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.